

2SK2407

NチャンネルMOS形シリコン電界効果トランジスタ
超高速スイッチング用

暫定規格

特長 ・高速ダイオード内蔵。

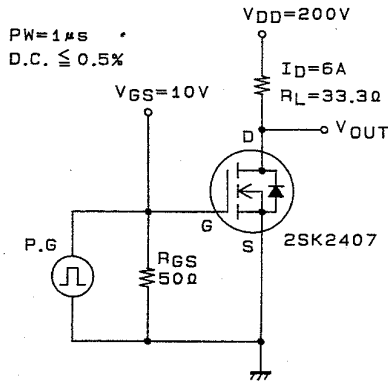
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta = 25°C

			unit
ドレイン・ソース電圧	V _{DSS}	450	V
ゲート・ソース電圧	V _{GSS}	±30	V
ドレイン電流 (DC)	I _D	10	A
ドレイン電流 (パルス)	I _{DP}	40	A
許容損失	P _D	70	W
		1.75	W
チャンネル温度	T _{ch}	150	°C
保存周囲温度	T _{stg}	-55~+150	°C

電気的特性 Electrical Characteristics / Ta = 25°C

			min	typ	max	unit
ドレイン・ソース降伏電圧	V _{(BR)DSS}	I _D = 1mA, V _{GS} = 0	450			V
ドレイン・ソースしゃ断電流	I _{DSS}	V _{DS} = 450V, V _{GS} = 0			1.0	mA
ゲート・ソースもれ電流	I _{GSS}	V _{GS} = ±30V, V _{DS} = 0			±100	nA
カットオフ電圧	V _{GS(off)}	V _{DS} = 10V, I _D = 1mA	2.0		3.0	V
順伝達アドミタンス	Y _{fs}	V _{DS} = 10V, I _D = 6A	3.0	6.0		S
飽和抵抗	R _{DS(on)}	I _D = 6A, V _{GS} = 10V		0.55	0.75	Ω
入力容量	C _{iss}	V _{DS} = 20V, f = 1MHz		1500		pF
出力容量	C _{oss}	V _{DS} = 20V, f = 1MHz		220		pF
帰還容量	C _{rss}	V _{DS} = 20V, f = 1MHz		75		pF
ターンオン遅延時間	t _{d(on)}	下図指定測定回路において		25		ns
立ち上がり時間	t _r	"		60		ns
ターンオフ遅延時間	t _{d(off)}	"		230		ns
下降時間	t _f	"		60		ns
ダイオード順電圧	V _{SD}	I _S = 10A, V _{GS} = 0			1.5	V
ダイオード逆回復時間	t _{rr}	I _S = 10A, di/dt = 100A/μs		150		ns

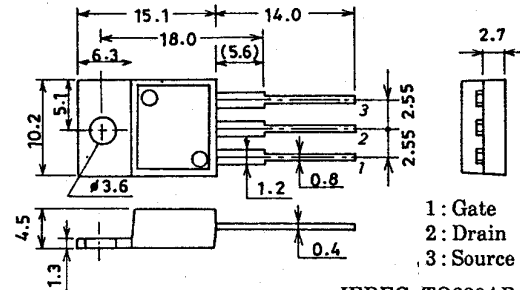
スイッチングタイム測定回路



A05062

本製品は開発中です。
詳細については営業担当者にご連絡ください。

外形図 2052C
(unit: mm)



1: Gate
2: Drain
3: Source

JEDEC: TO220AB
EIAJ : SC46